

List of patents and patent applications

Number	Publication Number	Publication Date	Inventors	Title
396	KR201783499 (B1)	29.09.2017	KREUPL FRANZ [DE]; PING ER XUAN [US]; ZHANG JINGYAN [US]; XU HUIWEN [CN]	MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME
395	EP000002583322B1	05.04.2017	KREUPL FRANZ, US ; SHRIVASTAVA RITU, US	MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS AND LATERAL ARRANGEMENT
394	EP000002583324B1	05.04.2017	FU CHU-CHEN, US; KREUPL FRANZ, US; NIAN YIBO, US	MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS INCLUDING BREAKDOWN LAYER
393	EP 2583323 B1	20.04.2016	KREUPL FRANZ, US ; MAKALA RAGHUVVEER S, US ; RABKIN PETER, US ; SAMACHISA GEORGE, US ; BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US ; CHEN YUNG-TIN, US ; FU CHU-CHEN, US ; JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US ; KAI JAMES, US ; ZHANG JINGYAN, US	COMPOSITION OF MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS
392	EP 2539936 B1	06.04.2016	KREUPL FRANZ, DE ; XU HUIWEN, US ; ZHANG JINGYAN, US	METHODS FOR FORMING A MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING CARBON SWITCHING LAYER
391	CN103168372 B	25.11.2015	弗朗茨·克罗伊普尔, 阿比吉特·班迪奥帕迪娅伊, 陈荣庭, 傅竹晨, 维普尔·彭西里·贾亚塞卡拉, 詹姆斯·凯, 拉古维尔·S·马卡拉, 彼得·拉布金, 乔治·萨马基沙, 张京燕	具有电阻开关层的存储单元的组合
390	US 9177995 B2	03.11.2015	Martin Gutsche; Franz Kreupl; Harald Seidl	Vertical interconnect structure, memory device and associated production method
389	EP 2559068 B8	08.07.2015	KREUPL FRANZ, DE PING ER-XUAN, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME
388	EP 2548238 B8	17.06.2015	KREUPL FRANZ, US ; MAKALA RAGHUVVEER S, US ; SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	METHOD OF FORMING BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
387	CN 103003971 B	03.06.2015	FU CHU-CHEN; KREUPL FRANZ; NIAN YIBO 弗朗茨·克罗伊普尔, 付初辰, 年一波	具有包括击穿层的电阻开关层的存储单元[EN] Memory cell with resistance-switching layers including breakdown layer
386	EP 2559068 B1	20.05.2015	KREUPL FRANZ, DE ; PING ER-XUAN, US ; XU HUIWEN, US ; ZHANG JINGYAN, US	MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME
385	US 9034689 B2	19.05.2015	Sekar; Deepak C. (San Jose, CA), Kreupl; Franz (Mountain View, CA), Rabkin; Peter (Cupertino, CA), Fu; Chu-Chen (San Ramon, CA)	Non-volatile storage with metal oxide switching element and methods for fabricating the same

384	EP 2548238 B1	22.04.2015	SEKAR DEEPAK CHANDRA, US; KREUPL FRANZ, US ; MAKALA RAGHUVVEER S, US	METHOD OF FORMING BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
383	CN 102986048 B	1.04.2015	KREUPL FRANZ; SHRIVASTAVA RITU 弗朗茨·克罗伊普尔, 里图·什里瓦斯塔瓦	具有电阻开关层以及侧向布置的存储单元 [EN] Memory cell with resistance-switching layers and lateral arrangement
382	US 8987046 B2	24.03.2015	SEKAR DEEPAK C, US; KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVVEER S, US RABKIN PETER, US	[EN] Trap passivation in memory cell with metal oxide switching element
381	DE000010250830B4	26.02.2015	Graham, Andrew, Hoffmann, Franz, Hönlein, Wolfgang, Kretz, Johannes, Kreupl, Franz, Landgraf, Erhard, Luyken, R. Johannes, Rösner, Wolfgang, Schulz, Thomas, Specht, Michael,	Verfahren zum Herstellung eines Schaltkreis-Arrays
380	DE102007011837B4	29.01.2015	FRANZ KREUPL	Integrierter Schaltkreis mit modifizierbarem Gate-Stapel-Speicherelement, Verwendung des integrierten Schaltkreises, Verfahren zum Herstellen eines integrierten Schaltkreises, sowie Speichermodul, System und hybrides Massenspeichersystem
379	US 8912654 B2	16.12.2014	KREUPL FRANZ, HEDLER HARRY	[EN] Semiconductor chip with integrated via
378	US 8772749 B2	08.07.2014	KREUPL FRANZ, DE ; MAKALA RAGHUVVEER S, US ; SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[EN] Bottom electrodes for use with metal oxide resistivity switching layers
377	DE102007001130B4	03.07.2014	Hedler, Harry, Irsigler, Roland, Kreupl, Franz,	Verfahren zum Herstellen einer Durchkontaktierung in einer Schicht und Anordnung mit einer Schicht mit Durchkontaktierung
376	US 8742387 B2	03.06.2014	Happ; Thomas (Dresden, DE), Kreupl; Franz (Munich, DE), Philipp; Jan Boris (Munich, DE), Majewski; Petra (Munich, DE)	Resistive memory devices with improved resistive changing elements
375	US 8737111 B2	27.05.2014	Kreupl; Franz (Munich, DE), Costa; Xiyang (San Jose, CA), Kai; James (Santa Clara, CA), Makala; Raghuvveer S. (Sunnyvale, CA)	Memory cell with resistance-switching layers

374	KR20140052984 (A)	07.05.2014	LEE SANG HYUN [KR]; DUNGA MOHAN [IN]; HIGASHITANI MASAOKI [JP]; PHAM TUAN [US]; KREUPL FRANZ [DE]	P-/METAL FLOATING GATE NON-VOLATILE STORAGE ELEMENT
373	US 8686419 B2	01.04.2014	Kreupl; Franz (Mountain View, CA), Sekar; Deepak C (San Jose, CA)	Structure and fabrication method for resistance-change memory cell in 3-D memory
372	US 8664657 B2	04.03.2014	DUESBERG GEORG, DE ; KREUPL FRANZ, DE ; SEIDEL ROBERT, DE ; STEINLESBERGER GERNOT, DE	Electrical circuit with a nanostructure and method for producing a contact connection of a nanostructure
371	EP2689451 (A1)	29.01.2014	LEE SANGHYUN [US]; DUNGA MOHAN [US]; HIGASHITANI MASAOKI [US]; PHAM TUAN [US]; KREUPL FRANZ [US]	P-/METAL FLOATING GATE NON-VOLATILE STORAGE ELEMENT
370	US 8624293 B2	07.01.2014	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US KREUPL FRANZ, US MIHNEA ANDREI, US XIAO LI, US	Carbon/tunneling-barrier/carbon diode
369	US2013234099 (A1)	12.09.2013	SEKAR DEEPAK C [US]; KREUPL FRANZ [US]; MAKALA RAGHUVEER S [US]; RABKIN PETER [US]; FU CHU-CHEN [US]; ZHANG TONG [US]	US2013234099 (A1) - NON-VOLATILE STORAGE WITH METAL OXIDE SWITCHING ELEMENT AND METHODS FOR FABRICATING THE SAME

368	JP2013534724 (A)	05.09.2013	KREUPL FRANZ [DE]; BANDYOPADHYAY ABHIJIT [US]; CHEN YUNG TIN [US]; FU CHU CHEN [US]; JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI [US]; KAI JAMES [US]; MAKALA RAGHUVVEER S [IN]; RABKIN PETER [US]; SAMACHISA GEORGE [US]; ZHANG JINGYAN [US]	Memory Cell With Resistance-Switching Layers
367	JP2013534723 (A)	05.09.2013	KREUPL FRANZ [DE]; BANDYOPADHYAY ABHIJIT [US]; CHEN YUNG TIN [US]; FU CHU CHEN [US]; JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI [US]; KAI JAMES [US]; MAKALA RAGHUVVEER S [IN]; RABKIN PETER [US]; SAMACHISA GEORGE [US]; ZHANG JINGYAN [US]	Memory Cell With Resistance-Switching Layers
366	JP2013534722 (A)	05.09.2013	KREUPL FRANZ [DE]; BANDYOPADHYAY ABHIJIT [US]; CHEN YUNG TIN [US]; FU CHU CHEN [US]; JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI [US]; KAI JAMES [US]; MAKALA RAGHUVVEER S [IN]; RABKIN PETER [US]; SAMACHISA GEORGE [US]; ZHANG JINGYAN [US]	Memory Cell With Resistance-Switching Layers
365	KR20130097139 (A)	02.09.2013	KREUPL FRANZ [DE]; BANDYOPADHYAY ABHIJIT [US]; CHEN YUNG TIN [US]; FU CHU CHEN [US]; JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI [US]; KAI JAMES [US]; MAKALA RAGHUVVEER S [IN]; RABKIN PETER [US]; SAMACHISA GEORGE [US]; ZHANG JINGYAN [US]	COMPOSITION OF MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS
364	US2013221311(A1)	29.08.2013	SEKAR DEEPAK C [US]; KREUPL FRANZ [US]; MAKALA RAGHUVVEER S [US]; RABKIN PETER [US]	TRAP PASSIVATION IN MEMORY CELL WITH METAL OXIDE SWITCHING ELEMENT
363	US 8520424 B2	27.08.2013	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US CHEN YUNG-TIN, US FU CHU-CHEN, US JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US RABKIN PETER, US SAMACHISA GEORGE, US ZHANG JINGYAN, US	Composition of memory cell with resistance-switching layers

362	US 8503229 B2	06.08.2013	DUNGA MOHAN, US HIGASHITANI MASAOKI, US KREUPL FRANZ, DE LEE SANGHYUN, US PHAM TUAN, US	P-/Metal floating gate non-volatile storage element
361	US 8487292 B2	16.07.2013	SEKAR DEEPAK C, US; KREUPL FRANZ, US	[EN] Resistance-switching memory cell with heavily doped metal oxide layer
360	US 8471360 B2	25.06.2013	Kreupl; Franz (Mountain View, CA), Ping; Er-Xuan (Fremont, CA), Zhang; Jingyan (Santa Clara, CA), Xu; Huiwen (Sunnyvale, CA)	MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME
359	CN000103168372A	19.06.2013	BANDYOPADHYAY ABHIJIT CHEN YUNG-TIN FU CHU- CHEN JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI KAI JAMES KREUPL FRANZ MAKALA RAGHUVVEER S RABKIN PETER SAMACHISA GEORGE ZHANG JINGYAN	[EN] Composition of memory cell with resistance-switching layers
358	JP2013524551 (A)	17.06.2013	KREUPL FRANZ [DE]; PING ER XUAN [US]; ZHANG JINGYAN [US]; XU HUIWEN [CN]	MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME
357	KR20130056860A	30.05.2013	KREUPL FRANZ [DE]; PING ER XUAN [US]; ZHANG JINGYAN [US]; XU HUIWEN [CN]	MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME

356	KR20130056205A	29.05.2013	KREUPL FRANZ [DE]; ZHANG JINGYAN [US]; XU HUIWEN [CN]	MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING CARBON SWITCHING LAYER AND METHODS FOR FORMING THE SAME
355	US2013126821A1	23.05.2013	Sekar; Deepak Chandra; (San Jose, CA) ; Kreupl; Franz; (Munche n, DE) ; Makala; Raghuveer S.; (Sunnyvale, CA)	BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
354	US000008435831B2	07.05.2013	KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVEER, US RABKIN PETER, US SEKAR DEEPAK C, US	Non-volatile storage with metal oxide switching element and methods for fabricating the same
353	EP000002583322A2	24.04.2013	KREUPL FRANZ, US SHRIVASTAVA RITU, US	[DE] SPEICHERZELLE MIT WIDERSTANDSSCHALTSCHICHTEN UND LATERALER ANORDNUNG [EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE- SWITCHING LAYERS AND LATERAL ARRANGEMENT [FR] CELLULE DE M ÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION ...
352	EP000002583323A2	24.04.2013	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US CHEN YUNG-TIN, US FU CHU-CHEN, US JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVEER S, US RABKIN PETER, US SAMACHISA GEORGE, US ZHANG JINGYAN, US	[DE] ZUSAMMENSETZUNG EINER SPEICHERZELLE MIT WIDERSTANDSSCHALTSCHICHTEN [EN] COMPOSITION OF MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS [FR] COMPOSITION DE CELLULE DE M ÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION ...
351	EP000002583324A1	24.04.2013	FU CHU-CHEN, US KREUPL FRANZ, US NIAN YIBO, US	[DE] SPEICHERZELLE MIT WIDERSTANDSSCHALTSCHICHTEN UND EINER DURCHBRUCHSCHICHT [EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS INCLUDING BREAKDOWN LAYER [FR] CELLULE M ÉMOIRE DOT ÉE DE COUCHES À COMMUTATION ...
350	US000008420526B2	16.04.2013	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] Vertical interconnect structure, memory device and associated production method

349	KR102013036279A	11.04.2013	KREUPL FRANZ, US SHRIVASTAVA RITU, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS AND LATERAL ARRANGEMENT
348	KR102013036292A	11.04.2013	KREUPL FRANZ [US]; FU CHU CHEN [US]; NIAN YIBO [CN]	MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS INCLUDING BREAKDOWN LAYER
347	CN000103003971A	27.03.2013	FU CHU-CHEN KREUPL FRANZ NIAN YIBO	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS INCLUDING BREAKDOWN LAYER
346	CN000102986048A	20.03.2013	KREUPL FRANZ SHRIVASTAVA RITU	[EN] Memory cell with resistance-switching layers and lateral arrangement
345	US000008395926B2	12.03.2013	KREUPL FRANZ, DE SHRIVASTAVA RITU, US	Memory cell with resistance-switching layers and lateral arrangement
344	US000008395927B2	12.03.2013	FU CHU-CHEN, US KREUPL FRANZ, DE NIAN YIBO, US	Memory cell with resistance-switching layers including breakdown layer
343	EP000002559068A1	20.02.2013	KREUPL FRANZ, DE PING ER-XUAN, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[DE] SPEICHERZELLE MIT KOHLENSTOFFSCHALTMATERIAL MIT VERRINGERTEM QUERSCHNITTSBEREICH UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [EN] MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL ...
342	CN000102939655A	20.02.2013	KREUPL FRANZ PING ER- XUAN XU HUIWEN ZHANG JINGYAN	[EN] Memory cell with carbon switching material having a reduced cross-sectional area and methods for forming the same
341	EP000002548238A1	23.01.2013	KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVEER S, US SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[DE] BODENELEKTRODEN ZUR VERWENDUNG MIT METALLOXIDWIDERSTANDSSCHALTSCHIC HTEN [EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS [FR] ÉLECTRODES INFÉRIEURES POUR UNE UTILISATION ...
340	EP000002548239A1	23.01.2013	KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVEER S, US SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[DE] BODENELEKTRODEN ZUR VERWENDUNG MIT METALLOXIDWIDERSTANDSSCHALTSCHIC HTEN [EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS [FR] ÉLECTRODES INFÉRIEURES POUR UNE UTILISATION ...
339	KR102013007572A	18.01.2013	KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVEER S, IN SEKAR DEEPAK CHANDRA, IN	BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS

338	KR102013007571A	18.01.2013	KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVeer S, IN SEKAR DEEPAK CHANDRA, IN	BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
337	US000008354660B2	15.01.2013	KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVeer S, US SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[EN] Bottom electrodes for use with metal oxide resistivity switching layers
336	CN000102870246A	09.01.2013	BANDYOPADHYAY ABHIJIT KREUPL FRANZ LI XIAO MIHNEA ANDREI	[EN] Carbon/tunneling-barrier/carbon diode
335	EP000002539936A2	02.01.2013	KREUPL FRANZ, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[DE] SPEICHERZELLE MIT SILIZIUMHALTIGER KOHLENSTOFFSCHALTSCHICHT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [EN] MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING CARBON SWITCHING LAYER AND METHODS FOR FORMING THE SAME [FR] ...
334	US020120305873A1	06.12.2012	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] VERTICAL INTERCONNECT STRUCTURE, MEMORY DEVICE AND ASSOCIATED PRODUCTION METHOD
333	US000008319259B2	27.11.2012	KREUPL FRANZ, DE SEIDL ROBERT, DE	[EN] Semiconductor power switch having nanowires
332	EP000002513994A2	24.10.2012	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US KREUPL FRANZ, US LI XIAO, US MIHNEA ANDREI, US	[DE] KOHLENSTOFF/TUNNELBARRIERE/KOHLNSTOFFDIODE [EN] CARBON/TUNNELING-BARRIER/CARBON DIODE [FR] DIODE CARBONE/BARRIÈRE-TUNNEL/CARBONE
331	EP000001706906B1	03.10.2012	KREUPL FRANZ, DE SEIDL ROBERT, DE	[DE] HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER MIT NANODRÄHTEN SOWIE DAFÜR GEEIGNETES HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] POWER SEMICONDUCTOR SWITCH HAVING NANOWIRES AND SUITABLE PRODUCTION METHOD THEREFOR [FR] COMMUTATEUR ...
330	TW000201240022A	01.10.2012	DUNGA MOHAN, IN HIGASHITANI MASA AKI, JP KREUPL FRANZ, DE LEE SANG-HYUN, KR PHAM TUAN, US	[EN] P-/metal floating gate non-volatile storage element

329	WO002012129032A 1	27.09.2012	DUNGA MOHAN, US HIGASHITANI MASAOKI, US KREUPL FRANZ, DE LEE SANGHYUN, US PHAM TUAN, US	[EN] P-/METAL FLOATING GATE NON- VOLATILE STORAGE ELEMENT [FR] ÉLÉMENT DE MÉMOIRE NON VOLATILE À GRILLE FLOTTANTE DU TYPE P-/MÉTAL
328	US020120243337A1	27.09.2012	DUNGA MOHAN, US HIGASHITANI MASAOKI, US KREUPL FRANZ, DE LEE SANGHYUN, US PHAM TUAN, US	[EN] P-/METAL FLOATING GATE NON- VOLATILE STORAGE ELEMENT
327	US000008254166B2	28.08.2012	GRUENING-VON SCHWERIN ULRIKE, DE KLOSTERMAN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Integrated circuit including doped semiconductor line having conductive cladding
326	WO002011159582A 4	23.08.2012	KREUPL FRANZ, US SHRIVASTAVA RITU, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE- SWITCHING LAYERS AND LATERAL ARRANGEMENT [FR] CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE ET DISPOSITION LATÉRALE
325	US000008237146B2	07.08.2012	KREUPL FRANZ, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] Memory cell with silicon-containing carbon switching layer and methods for forming the same
324	WO002011159583A 4	02.08.2012	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US CHEN YUNG-TIN, US FU CHU-CHEN, US JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVEER S, US RABKIN PETER, US SAMACHISA GEORGE, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] COMPOSITION OF MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS [FR] COMPOSITION DE CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE
323	US000008216639B2	10.07.2012	DUESBERG GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[EN] Methods for elimination or reduction of oxide and/or soot deposition in carbon containing layers
322	US000008216862B2	10.07.2012	KREUPL FRANZ, US SEKAR DEEPAK C, US	[EN] Forming and training processes for resistance-change memory cell
321	WO002011159582A 3	05.07.2012	KREUPL FRANZ, US SHRIVASTAVA RITU, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE- SWITCHING LAYERS AND LATERAL ARRANGEMENT [FR] CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE ET DISPOSITION LATÉRALE

320	WO002011159583A 3	14.06.2012	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US CHEN YUNG-TIN, US FU CHU-CHEN, US JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US RABKIN PETER, US SAMACHISA GEORGE, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] COMPOSITION OF MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS [FR] COMPOSITION DE CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE
319	WO002011159581A 3	19.04.2012	COSTA XIYING, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS [FR] CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE
318	US020120091418A1	19.04.2012	CHEN YUNG-TIN, US HOU KUN, US KREUPL FRANZ, US MAXWELL STEVEN, US	[EN] BIPOLAR STORAGE ELEMENTS FOR USE IN MEMORY CELLS AND METHODS OF FORMING THE SAME
317	WO002011159584A 4	22.03.2012	FU CHU-CHEN, US KREUPL FRANZ, US NIAN YIBO, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS INCLUDING BREAKDOWN LAYER [FR] CELLULE MÉMOIRE DOTÉE DE COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE COMPRENANT UNE COUCHE DE CLAQUAGE
316	TW000201212317A	16.03.2012	COSTA XIYING, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, IN	[EN] Memory cell with resistance-switching layers
315	TW000201212318A	16.03.2012	KREUPL FRANZ, DE SHRIVASTAVA RITU, US	[EN] Memory cell with resistance-switching layers and lateral arrangement
314	TW000201212319A	16.03.2012	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US CHEN YUNG-TIN, US FU CHU-CHEN, US JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, IN RABKIN PETER, US SAMACHISA GEORGE, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] Composition of memory cell with resistance-switching layers
313	TW000201209824A	01.03.2012	FU CHU-CHEN, US KREUPL FRANZ, DE NIAN YI-BO, CN	[EN] Memory cell with resistance-switching layers including breakdown layer

312	EP000001800360B1	22.02.2012	DUESBERG GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR [EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR CONTACTING A NANOSTRUCTURE ...
311	EP000001916722B1	18.01.2012	KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE UFERT KLAUS- DIETER, DE	[DE] Karbonfilamentspeicher und Herstellungsverfahren dafür [EN] Carbon filament memory and fabrication method [FR] Mémoire de filament de carbone et procédé de fabrication
310	US000008097872B2	17.01.2012	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Modifiable gate stack memory element
309	TW000201203249A	16.01.2012	KREUPL FRANZ, DE SEKAR DEEPAK C, IN	[EN] Structure and fabrication method for resistance-change memory cell in 3-D memory
308	TW000201203640A	16.01.2012	KREUPL FRANZ, DE PING ER-XUAN, US XU HUI-WEN, CN ZHANG JINGYAN, US	[EN] Memory cell with carbon switching material having a reduced cross-sectional area and methods for forming the same
307	US000008084759B2	27.12.2011	KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWERIN ULRIKE GRUENING-VON, DE	[EN] Integrated circuit including doped semiconductor line having conductive cladding
306	WO002011159581A 2	22.12.2011	COSTA XIYING, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE- SWITCHING LAYERS [FR] CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE
305	WO002011159582A 2	22.12.2011	KREUPL FRANZ, US SHRIVASTAVA RITU, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE- SWITCHING LAYERS AND LATERAL ARRANGEMENT [FR] CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE ET DISPOSITION LATÉRALE
304	WO002011159583A 2	22.12.2011	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US CHEN YUNG-TIN, US FU CHU-CHEN, US JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US RABKIN PETER, US SAMACHISA GEORGE, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] COMPOSITION OF MEMORY CELL WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS [FR] COMPOSITION DE CELLULE DE MÉMOIRE AVEC COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE
303	WO002011159584A 1	22.12.2011	FU CHU-CHEN, US KREUPL FRANZ, US NIAN YIBO, US	[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE- SWITCHING LAYERS INCLUDING BREAKDOWN LAYER [FR] CELLULE MÉMOIRE DOTÉE DE COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTANCE COMPRENANT UNE COUCHE DE CLAQUAGE

302	US020110310653A1	22.12.2011	COSTA XIYING, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US	[EN] Memory Cell With Resistance-Switching Layers
301	US020110310654A1	22.12.2011	KREUPL FRANZ, DE SHRIVASTAVA RITU, US	[EN] Memory Cell With Resistance-Switching Layers And Lateral Arrangement
300	US020110310655A1	22.12.2011	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US CHEN YUNG-TIN, US FU CHU-CHEN, US JAYASEKARA WIPUL PEMSIRI, US KAI JAMES, US KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US RABKIN PETER, US SAMACHISA GEORGE, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] Composition Of Memory Cell With Resistance-Switching Layers
299	US020110310656A1	22.12.2011	FU CHU-CHEN, US KREUPL FRANZ, DE NIAN YIBO, US	[EN] Memory Cell With Resistance-Switching Layers Including Breakdown Layer
298	TW000201145632A	16.12.2011	KREUPL FRANZ, DE XU HUI-WEN, CN ZHANG JINGYAN, US	[EN] Memory cell with silicon-containing carbon switching layer and methods for forming the same
297	TW000201145633A	16.12.2011	KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, IN SEKAR DEEPAK CHANDRA, IN	[EN] Bottom electrodes for use with metal oxide resistivity switching layers
296	TW000201145634A	16.12.2011	KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, IN SEKAR DEEPAK CHANDRA, IN	[EN] Bottom electrodes for use with metal oxide resistivity switching layers
295	US000008063394B2	22.11.2011	ANDRES DIETER, DE BRUCHHAUS RAINER, US GRUENING-VON SCHWERIN ULRIKE, DE KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE MAJEWSKI PETRA, DE RUESTER CHRISTIAN, DE RUF BERNHARD, DE SYMANCZYK RALF, DE UFERT KLAUS-DIETER, DE	[EN] Integrated circuit
294	WO002011106155A3	03.11.2011	KREUPL FRANZ, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING CARBON SWITCHING LAYER AND METHODS FOR FORMING THE SAME [FR] CELLULE MÉMOIRE DOTÉ D'UNE COUCHE DE COMMUTATION DE CARBONE CONTENANT DU SILICIUM ET PROCÉDÉS DE ...

293	WO002011106329A 4	27.10.2011	KREUPL FRANZ, US SEKAR DEEPAK C, US	[EN] STRUCTURE AND FABRICATION METHOD FOR RESISTANCE-CHANGE MEMORY CELL IN 3-D MEMORY [FR] STRUCTURE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE CELLULE MÉMOIRE À CHANGEMENT DE RÉSISTANCE DANS UNE MÉMOIRE 3D
292	WO002011130212A 1	20.10.2011	KREUPL FRANZ, DE PING ER-XUAN, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME [FR] CELLULE MÉMOIRE DOTÉE D'UN MATÉRIAU DE COMMUTATION EN CARBONE PRÉSENTANT UNE ...
291	US020110254126A1	20.10.2011	KREUPL FRANZ, US PING ER-XUAN, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND METHODS FOR FORMING THE SAME
290	US020110248234A1	13.10.2011	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] VERTICAL INTERCONNECT STRUCTURE, MEMORY DEVICE AND ASSOCIATED PRODUCTION METHOD
289	TW000201133867A	01.10.2011	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US KREUPL FRANZ, DE MIHNEA ANDREI, US XIAO LI, US	[EN] Carbon/tunneling-barrier/carbon diode
288	WO002011115924A 1	22.09.2011	KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVVEER S, US SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS [FR] ÉLECTRODES INFÉRIEURES POUR UNE UTILISATION AVEC DES COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTIVITÉ D'OXYDE MÉTALLIQUE
287	WO002011115926A 1	22.09.2011	KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVVEER S, US SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS [FR] ÉLECTRODES INFÉRIEURES POUR UNE UTILISATION AVEC DES COUCHES À COMMUTATION DE RÉSISTIVITÉ D'OXYDE MÉTALLIQUE
286	US020110227020A1	22.09.2011	KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVVEER S, US SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
285	US020110227024A1	22.09.2011	KREUPL FRANZ, US SEKAR DEEPAK C, US	[EN] RESISTANCE-SWITCHING MEMORY CELL WITH HEAVILY DOPED METAL OXIDE LAYER
284	US020110227026A1	22.09.2011	FU CHU-CHEN, US KREUPL FRANZ, US MAKALA RAGHUVVEER, US RABKIN PETER, US SEKAR DEEPAK C, US ZHANG TONG, US	[EN] NON-VOLATILE STORAGE WITH METAL OXIDE SWITCHING ELEMENT AND METHODS FOR FABRICATING THE SAME

283	US020110227028A1	22.09.2011	KREUPL FRANZ, DE MAKALA RAGHUVeer S, US SEKAR DEEPAK CHANDRA, US	[EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
282	US020110229990A1	22.09.2011	KREUPL FRANZ, US SEKAR DEEPAK C, US	[EN] FORMING AND TRAINING PROCESSES FOR RESISTANCE-CHANGE MEMORY CELL
281	WO002011084334A3	01.09.2011	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US KREUPL FRANZ, US LI XIAO, US MIHNEA ANDREI, US	[EN] CARBON/TUNNELING-BARRIER/CARBON DIODE [FR] DIODE CARBONE/BARRIÈRE-TUNNEL/CARBONE
280	WO002011106155A2	01.09.2011	KREUPL FRANZ, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING CARBON SWITCHING LAYER AND METHODS FOR FORMING THE SAME [FR] CELLULE MÉMOIRE DOTÉ D'UNE COUCHE DE COMMUTATION DE CARBONE CONTENANT DU SILICIUM ET PROCÉDÉS DE ...
279	WO002011106329A1	01.09.2011	KREUPL FRANZ, US SEKAR DEEPAK C, US	[EN] STRUCTURE AND FABRICATION METHOD FOR RESISTANCE-CHANGE MEMORY CELL IN 3-D MEMORY [FR] STRUCTURE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE CELLULE MÉMOIRE À CHANGEMENT DE RÉSISTANCE DANS UNE MÉMOIRE 3D
278	US020110204316A1	25.08.2011	KREUPL FRANZ, US SEKAR DEEPAK C, US	[EN] Structure And Fabrication Method For Resistance-Change Memory Cell In 3-D Memory
277	US020110204474A1	25.08.2011	KREUPL FRANZ, US XU HUIWEN, US ZHANG JINGYAN, US	[EN] MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING CARBON SWITCHING LAYER AND METHODS FOR FORMING THE SAME
276	US000007998858B2	16.08.2011	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] Vertical interconnect structure, memory device and associated production method
275	WO002011084334A2	14.07.2011	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US KREUPL FRANZ, US LI XIAO, US MIHNEA ANDREI, US	[EN] CARBON/TUNNELING-BARRIER/CARBON DIODE [FR] DIODE CARBONE/BARRIÈRE-TUNNEL/CARBONE
274	US020110140064A1	16.06.2011	BANDYOPADHYAY ABHIJIT, US KREUPL FRANZ, US MIHNEA ANDREI, US XIAO LI, US	[EN] CARBON/TUNNELING-BARRIER/CARBON DIODE
273	DE102007014979B4	21.04.2011	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Integrierter Schaltkreis mit Kohlenstoff-Speicherschicht, Verfahren zur Herstellung, Speichermodul und Computersystem
272	US000007915603B2	29.03.2011	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Modifiable gate stack memory element
271	US000007910210B2	22.03.2011	DUESBERG GEORG, DE KAPTEYN CHRISTIAN, DE KREUPL FRANZ, DE LIEBAU MAIK, DE	[EN] Method of producing a layer arrangement, method of producing an electrical component, layer arrangement, and electrical component

270	US000007902616B2	08.03.2011	KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Integrated circuit having a magnetic tunnel junction device and method
269	EP000002278590A3	02.03.2011	DE AMBROGGI LUCA, DE HAPP THOMAS, DE KREUPL FRANZ, DE PHILIPP JAN BORIS, DE PHO-DUC CRISTIAN, DE SCHROEGMEIER PETER, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] Integrierte Speicherschaltung mit begrenztem Lesezugriff [EN] Integrated circuit including memory having limited read [FR] Circuit intégré de mémoire avec accès en lecture limité
268	US000007894253B2	22.02.2011	KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE UFERT KLAUS-DIETER, DE	[EN] Carbon filament memory and fabrication method
267	EP000002278590A2	26.01.2011	DE AMBROGGI LUCA, DE HAPP THOMAS, DE KREUPL FRANZ, DE PHILIPP JAN BORIS, DE PHO-DUC CRISTIAN, DE SCHROEGMEIER PETER, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] Integrierte Speicherschaltung mit begrenztem Lesezugriff [EN] Integrated circuit including memory having limited read [FR] Circuit intégré de mémoire avec accès en lecture limité
266	DE102008051746A1	20.01.2011	Grüning von Schwerin, Ulrike, Dr., 81735 München, DE Klostermann, Ulrich, Dr., 81739 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Integrierter Schaltkreis mit dotierter Halbleiterleitung mit leitfähiger Verkleidung
265	EP000001916722A3	19.01.2011	KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE UFERT KLAUS-DIETER, DE	[DE] Karbonfilamentspeicher und Herstellungsverfahren dafür [EN] Carbon Filament Memory and Fabrication Method [FR] Mémoire de filament de carbone et procédé de fabrication
264	US000007863700B2	04.01.2011	KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Magnetoresistive sensor with tunnel barrier and method
263	EP000001597760B1	15.12.2010	GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] INTEGRIERTES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GEZIELT ERZEUGTEN NANORÖHREN IN VERTIKALEN STRUKTUREN [EN] INTEGRATED ELECTRONIC COMPONENT HAVING SPECIFICALLY PRODUCED NANOTUBES IN VERTICAL STRUCTURES ...
262	TW000001333261B	11.11.2010	CHRISTIAN KAPTEYN, DE FRANZ KREUPL, DE GEORG DUESBERG, DE MAIK LIEBAU, DE	[EN] Method for producing a layer arrangement, method for producing an electrical component, layer arrangement, and electrical component

261	EP000001390295B1	13.10.2010	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE	[DE] NANORÖHREN-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER NANORÖHREN-ANORDNUNG [EN] NANOTUBE ARRAY AND METHOD FOR PRODUCING A NANOTUBE ARRAY [FR] ENSEMBLE A NANOTUBES ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN ...
260	US000007768016B2	03.08.2010	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Carbon diode array for resistivity changing memories
259	CN000101170159B	09.06.2010	FRANZ KREUPL KLAUS- DIETER UFERT MICHAEL KUND	[EN] Carbon filament memory and fabrication method
258	US000007728405B2	01.06.2010	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Carbon memory
257	US000007709827B2	04.05.2010	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN JOHANNES RICHARD, DE ROESNER WOLFGANG, US SCHULZ THOMAS, US SPECHT MICHAEL, DE	[EN] Vertically integrated field-effect transistor having a nanostructure therein
256	DE000010393702B4	15.04.2010	Hoffmann, Franz, Dr., 80995 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen einer Speicherzelle, Speicherzelle und Speicherzellen-Anordnung
255	US020100084741A1	08.04.2010	ANDRES DIETER, DE BRUCHHAUS RAINER, US GRUENING-VON SCHWERIN ULRIKE, DE KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE MAJEWSKI PETRA, DE RUESTER CHRISTIAN, DE RUF BERNHARD, DE SYMANCZYK RALF, DE UFERT KLAUS-DIETER, DE	[EN] Integrated Circuit
254	US020100061140A1	11.03.2010	GRUENING-VON SCHWERIN ULRIKE, DE KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING DOPED SEMICONDUCTOR LINE HAVING CONDUCTIVE CLADDING
253	US020100057685A1	04.03.2010	HARTER JOHANN, DE KREUPL FRANZ, DE LUHN GERHARD, DE	[EN] INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM
252	US000007646045B2	12.01.2010	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[EN] Method for fabricating a nanoelement field effect transistor with surrounded gate structure
251	DE102008037983A1	07.01.2010	Klostermann, Ulrich, Dr., 81739 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Magnetoresistiver Sensor mit Tunnelsperrschicht und Verfahren

250	US020090321706A1	31.12.2009	HAPP THOMAS, DE KREUPL FRANZ, DE MAJEWSKI PETRA, DE PHILIPP JAN BORIS, DE	[EN] Resistive Memory Devices with Improved Resistive Changing Elements
249	US020090321860A1	31.12.2009	KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] INTEGRATED CIRCUIT HAVING A MAGNETIC TUNNEL JUNCTION DEVICE AND METHOD
248	US020090322319A1	31.12.2009	KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] MAGNETORESISTIVE SENSOR WITH TUNNEL BARRIER AND METHOD
247	EP000001744323B1	30.12.2009	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[DE] Phasenwechsel- Speicherzelle mit Nanodrahtelektrode [EN] Phase change memory cell having nanowire electrode [FR] Cellule mémoire à changement de phase avec électrode de nanofil
246	US000007635867B2	22.12.2009	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD, DE ROESNER WOLFGANG, DE	[EN] Nanotube array and method for producing a nanotube array
245	US020090268513A1	29.10.2009	DE AMBROGGI LUCA, DE DUC CHRISTIAN PHO, DE KREUPL FRANZ, DE PHILIPP JAN BORIS, DE SCHROEGMEIER PETER, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[EN] MEMORY DEVICE WITH DIFFERENT TYPES OF PHASE CHANGE MEMORY
244	US020090256258A1	15.10.2009	HEDLER HARRY, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] SEMICONDUCTOR CHIP WITH INTEGRATED VIA
243	US020090212438A1	27.08.2009	HEDLER HARRY, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] INTEGRATED CIRCUIT DEVICE COMPRISING CONDUCTIVE VIAS AND METHOD OF MAKING THE SAME
242	US020090213830A1	27.08.2009	DUESBERG GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL ROBERT, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR PRODUCING A CONTACT CONNECTION OF A NANOSTRUCTURE
241	US020090201715A1	13.08.2009	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Carbon Diode Array for Resistivity Changing Memories
240	US020090199043A1	06.08.2009	DEAMBROGGI LUCA, DE DUC CHRISTIAN PHO, DE HAPP THOMAS, DE KREUPL FRANZ, DE PHILIPP JAN BORIS, DE SCHROEGMEIER PETER, DE STEINLESBERGER GERNOT, AT	[EN] ERROR CORRECTION IN AN INTEGRATED CIRCUIT WITH AN ARRAY OF MEMORY CELLS
239	CN000101447500A	03.06.2009	FRANZ KREUPL, DE ULRICH KLOSTERMANN, DE	[EN] Integrated circuit including doped semiconductor line having conductive cladding

238	JP002009111391A	21.05.2009	KREUPL FRANZ SCHWERIN ULRIKE GRUENING VON ULRICH KLOSTERMANN	[EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING DOPED SEMICONDUCTOR LINE HAVING CONDUCTIVE CLADDING
237	US020090108248A1	30.04.2009	KLOSTERMANN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWERIN ULRIKE GRUNING-VON, DE	[EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING DOPED SEMICONDUCTOR LINE HAVING CONDUCTIVE CLADDING
236	EP000001170799A3	01.04.2009	HOFMANN FRANZ DR, DE KREUPL FRANZ DR, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES DR, DE SCHLOESSER TILL DR, DE	[DE] Elektronisches Bauelement und Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauelements [EN] Electronic device and method of manufacture of an electronic device [FR] Dispositif électronique et procédé ...
235	US020090046499A1	19.02.2009	DE AMBROGGI LUCA, DE HAPP THOMAS, DE KREUPL FRANZ, DE PHILIPP JAN BORIS, DE PHO DUC CHRISTIAN, DE SCHROEGMEIER PETER, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING MEMORY HAVING LIMITED READ
234	DE102007037490A1	19.02.2009	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Willer, Josef, Dr., 85521 Riemerling, DE	[DE] Gestapelte Schaltungen
233	DE000010335813B4	12.02.2009	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Mio, Hannes, 82024 Taufkirchen, DE	[DE] IC-Chip mit Nanowires
232	CN000100459098C	04.02.2009	ANDREW GRAHAM, DE FRANZ KREUPL, DE ROBERT SEIDEL, DE	[EN] Integrated electronic component having specifically produced nanotubes in vertical structure and manufacturing method thereof
231	US020090026524A1	29.01.2009	KEITEL-SCHULZ DORIS, DE KREUPL FRANZ, DE WILLER JOSEF, DE	[EN] Stacked Circuits
230	CN000100456419C	28.01.2009	CHRISTIAN KAPTEYN, DE FRANZ KREUPL, DE GEORG DUESBERG, DE MAIK LIEBAU, DE	[EN] Method of producing a layer arrangement, method of producing an electrical component, layer arrangement, and electrical component
229	DE000010202903B4	22.01.2009	Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE	[DE] Magnetoresistive Speicherzelle mit polaritätsabhängigem Widerstand und Speicherzelle
228	US020080315430A1	25.12.2008	KREUPL FRANZ, DE UNGER EUGEN, DE WEBER WALTER M, DE	[EN] NANOWIRE VIAS
227	US020080296557A1	04.12.2008	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[EN] Semiconductor Power Switch and Method for Producing a Semiconductor Power Switch

226	US020080296559A1	04.12.2008	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[EN] Method for Fabricating a Nanoelement Field Effect Transistor with Surrounded Gate Structure
225	CN000100428519C	22.10.2008	FRANZ HOFMANN, DE FRANZ KREUPL, DE	[EN] Method for the production of a memory cell, memory cell and memory cell arrangement
224	US000007425487B2	16.09.2008	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[EN] Method for fabricating a nanoelement field effect transistor with surrounded gate structure
223	US020080217732A1	11.09.2008	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Carbon memory
222	DE102007014979A1	11.09.2008	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Kohlenstoff-Speicher
221	US000007420199B2	02.09.2008	GUTSCHE MARTIN ULRICH, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] Resistivity changing memory cell having nanowire electrode
220	US000007413971B2	19.08.2008	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE STEINHOEGL WERNER, DE	[EN] Method of producing a layered arrangement and layered arrangement
219	TW000200830462A	16.07.2008	HEDLER HARRY, DE IRSIGLER ROLAND, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Method for making an integrated circuit having a via hole
218	US020080164611A1	10.07.2008	HEDLER HARRY, DE IRSIGLER ROLAND, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] METHOD FOR MAKING AN INTEGRATED CIRCUIT HAVING A VIA HOLE
217	DE102007001130A1	10.07.2008	Hedler, Harry, Dr., 82110 Germering, DE Irsigler, Roland, Dr., 81667 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen einer Durchkontaktierung in einer Schicht und Anordnung mit einer Schicht mit Durchkontaktierung
216	CN000101217128A	09.07.2008	FRANZ KREUPL, DE HARRY HEDLER, DE ROLAND IRSIGLER, DE	[EN] Method for making an integrated circuit having a via hole
215	JP002008153624A	03.07.2008	KREUPL FRANZ KUND MICHAEL UFERT KLAUS DIETER	[EN] CARBON FILAMENT MEMORY AND METHOD FOR FORMING IT
214	DE000010250868B8	26.06.2008	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Hofmann, Franz, Dr., 80995 München, DE Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kretz, Johannes, Dr., 80538 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Landgraf, Erhard, 81543 München, DE Luyken, Johannes R., Dr., 81825 München, DE Rösner, Wolfgang, Dr., 85521 Ottobrunn, DE Schulz, Thomas, 81737 München, DE Specht, Michael, Dr., 80799 München, DE	[DE] Vertikal integrierter Feldeffekttransistor, Feldeffekttransistor-Anordnung und Verfahren zum Herstellen eines vertikal integrierten Feldeffekttransistors

213	JP002008124452A	29.05.2008	KREUPL FRANZ	[EN] MODIFIABLE GATE STACK MEMORY ELEMENT
212	DE102007013595A1	08.05.2008	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Kund, Michael, Dr., 83104 Tuntenhausen, DE Ufert, Klaus-Dieter, Dr., 85716 Unterschleißheim, DE	[DE] Kohlenstoff-Filament-Speicher und Verfahren zum He
211	KR102008038044A	02.05.2008	KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE UFERT KLAUS DIETER, DE	[EN] CARBON FILAMENT MEMORY AND METHOD FOR FABRICATION
210	KR102008038045A	02.05.2008	KREUPL FRANZ, DE	[EN] MODIFIABLE GATE STACK MEMORY ELEMENT
209	US020080099752A1	01.05.2008	KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE UFERT KLAUS-DIETER, DE	[EN] Carbon filament memory and fabrication method
208	US020080099827A1	01.05.2008	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Modifiable gate stack memory element
207	US020080101121A1	01.05.2008	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Modifiable gate stack memory element
206	US020080102278A1	01.05.2008	KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE UFERT KLAUS-DIETER, DE	[EN] Carbon filament memory and method for fabrication
205	EP000001916722A2	30.04.2008	KREUPL FRANZ, DE KUND MICHAEL, DE UFERT KLAUS-DIETER, DE	[DE] Karbonfilamentspeicher und Herstellungsverfahren dafür [EN] Carbon filament memory and fabrication method [FR] Mémoire de filament de carbone et procédé de fabrication
204	DE102007011837A1	30.04.2008	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Modifizierbarer-Gate-Stapel-Speicherelement [EN] Integrated circuit e.g. dynamic RAM, for use in e.g. personal digital assistant, has gate-stack with resistive switching element whose conductivity ...
203	CN000101170132A	30.04.2008	FRANZ KREUPL, DE	[EN] Modifiable gate stack memory element
202	CN000101170159A	30.04.2008	FRANZ KREUPL, DE MICHAEL KUND, DE	[EN] Carbon filament memory and fabrication method
201	EP000001299914B1	02.04.2008	HANEDER THOMAS PETER, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE SCHLOESSER TILL, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR [FR] TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP

200	DE000010250868B4	06.03.2008	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Hofmann, Franz, Dr., 80995 München, DE Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kretz, Johannes, Dr., 80538 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Landgraf, Erhard, 81543 München, DE Luyken, Johannes R., Dr., 81825 München, DE Rösner, Wolfgang, Dr., 85521 Ottobrunn, DE Schulz, Thomas, 81737 München, DE Specht, Michael, Dr., 80799 München, DE	[DE] Vertikal integrierter Feldeffekttransistor, Feldeffekttransistor-Anordnung und Verfahren zum Herstellen eines vertikal integrierten Feldeffekttransistors
199	US000007339186B2	04.03.2008	KREUPL FRANZ, DE MIO HANNES, DE	[EN] IC chip with nanowires
198	US000007326465B2	05.02.2008	GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[EN] Integrated electronic component
197	US000007321097B2	22.01.2008	ENGELHARDT MANFRED, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Electronic component comprising an electrically conductive connection consisting of carbon nanotubes and a method for producing the same
196	US000007301779B2	27.11.2007	HOENLEIN WOLFGANG, DE KLOSE LEGAL REPRESENTATIVE HYA, DE KREUPL FRANZ, DE SIMBUERGER WERNER, DE	[EN] Electronic chip and electronic chip assembly
195	EP000001412948B1	14.11.2007	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] MAGNETISCHE SPEICHEREINHEIT UND MAGNETISCHES SPEICHERARRAY [EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND MAGNETIC MEMORY ARRAY [FR] UNITE MEMOIRE MAGNETIQUE ET MATRICE MEMOIRE MAGNETIQUE
194	EP000001502299B1	17.10.2007	DUESBERG GEORG STEFAN, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[DE] KONTAKTIERUNG VON NANORÖHREN [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR] ÉTABLISSEMENT DES CONTACTS DE NANOTUBES
193	EP000001198828B1	19.09.2007	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHIELE MANUELA, GB WEINRICH VOLKER, FR	[DE] VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERSPEICHERBAUELEMENTS [EN] METHOD FOR PRODUCING A SEMICONDUCTOR MEMORY COMPONENT [FR] PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COMPOSANT DE STOCKAGE A SEMI-CONDUCTEUR

192	US000007265376B2	04.09.2007	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, US SPECHT MICHAEL, DE	[EN] Non-volatile memory cell, memory cell arrangement and method for production of a non-volatile memory cell
191	KR102007089912A	04.09.2007	DUESBERG GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE STEINLESBERGER GERNOT, AT	[EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR CONTACTING A NANOSTRUCTURE
190	US020070187744A1	16.08.2007	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Integrated circuits, memory device, method of producing an integrated circuit, method of producing a memory device, memory module
189	DE102006004218B3	16.08.2007	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Elektromechanische Speicher-Einrichtung und Verfahren zum Herstellen einer elektromechanischen Speicher-Einrichtung
188	US020070176255A1	02.08.2007	BENZINGER HERBERT, DE BORMANN INGO, DE EGGERS GEORG E, DE KREUPL FRANZ, DE SCHNELL MARTIN, DE	[EN] Integrated circuit arrangement
187	DE000010345393B4	19.07.2007	Kreupl, Franz, 80802 München, DE Pamler, Werner, 80686 München, DE Seidel, Robert, 81539 München, DE	[DE] Verfahren zur Abscheidung eines leitfähigen Materials auf einem Substrat und Halbleiterkontaktvorrichtung
186	TW000001283917B	11.07.2007	HONLEIN WOLFGANG, DE KLOSE HELMUT, DE KREUPL FRANZ, DE SIMBURGER WERNER, AT	[EN] Electronic chip and electronic chip arrangement
185	DE102005051973B3	28.06.2007	Gutsche, Martin Ulrich, Dr., 84405 Dorfen, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Seidl, Harald, 85604 Zorneding, DE	[DE] Herstellungsverfahren für vertikale Leitbahnstruktur, Speichervorrichtung sowie zugehöriges Herstellungsverfahren
184	DE102005060723A1	28.06.2007	Gutsche, Martin Ulrich, Dr., 84405 Dorfen, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Seidl, Harald, 85604 Zorneding, DE	[DE] Nano-Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer Nano-Anordnung [EN] Nano-arrangement e.g. semiconductor-nano-arrangement, has freestanding structures superimposed on substrate, and nano-support ...

183	EP000001800360A2	27.06.2007	DUESBERG GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] ELEKTRISCHER SCHALTREIS MIT EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR [EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR CONTACTING A NANOSTRUCTURE ...
182	US020070141256A1	21.06.2007	DUSBER GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[EN] Methods for elimination or reduction of oxide and/or soot deposition in carbon containing layers
181	DE102006010512A1	21.06.2007	Duesberg, Georg, Dr., 81541 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Liebau, Maik, Dr., 81735 München, DE Unger, Eugen, Dr., 86161 Augsburg, DE	[DE] Verfahren zur Eliminierung oder Verringerung der Oxid- und/oder Russabscheidung in kohlenstoffhaltigen Schichten
180	DE102005058466A1	14.06.2007	Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Unger, Eugen, Dr., 86161 Augsburg, DE Weber, Walter Michael, 81379 München, DE	[DE] Selbstjustierte Strukturierung eines aktiven Kanals durch axiale Diffusion [EN] Semiconductor device manufacture, by diffusing material from diffusion reservoir into channel region to form conductive ...
179	US020070122621A1	31.05.2007	DUESBERG GEORG, DE KAPTEYN CHRISTIAN, DE KREUPL FRANZ, DE LIEBAU MAIK, DE	[EN] Method of producing a layer arrangement, method of producing an electrical component, layer arrangement, and electrical component
178	DE102005056262A1	31.05.2007	Düsberg, Georg Stefan, Dr., 81541 München, DE Kapteyn, Christian, Dr., 01099 Dresden, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Liebau, Maik, Dr., 81735 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen einer Schichtanordnung, Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Bauelementes, Schichtanordnung und elektrisches Bauelement [EN] Production of layer arrangement, such ...
177	CN000001971847A	30.05.2007	CHRISTIAN KREUPL FRANZ LIEBAU, DE	[EN] Method of producing a layer arrangement, method of producing an electrical component, layer arrangement, and electrical component
176	US020070105333A1	10.05.2007	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] Vertical interconnect structure, memory device and associated production method

175	DE000010201645B4	26.04.2007	Brederlow, Ralf, Dr., 81737 München, DE Elbe, Astrid, Dr., 81829 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Luyken, Johannes, Dr., 81825 München, DE Neuhauser, Robert, 85354 Freising, DE Paulus, Christian, 81247 München, DE Schepers, Jörg, Dr., 83700 Rottach-Egern, DE Thewes, Roland, Dr., 82194 Gröbenzell, DE	[DE] Verfahren zur Codierung und Authentifizierung von Halbleiterschaltungen
174	EP000001505646B1	28.02.2007	KREUPL FRANZ, DE MIO HANNES, DE	[DE] IC-Chip mit Nanowire-Bauelemente und Nanowire-Attrappen [EN] IC-Chip with nanowire devices and dummy nanowire devices [FR] Puce IC avec des dispositifs nanofils et des dispositifs fictifs nanofils
173	US020070018218A1	25.01.2007	KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[EN] Fin field effect transistor memory cell, fin field effect transistor memory cell arrangement and method for producing the fin field effect transistor memory cell
172	US020070012956A1	18.01.2007	GUTSCHE MARTIN U, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] Phase change memory cell having nanowire electrode
171	KR102007009482A	18.01.2007	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[EN] PHASE CHANGE MEMORY CELL HAVING NANOWIRE ELECTRODE
170	EP000001744323A1	17.01.2007	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDL HARALD, DE	[DE] Phasenwechsel- Speicherzelle mit Nanodrahtelektrode [EN] Phase change memory cell having nanowire electrode [FR] Cellule mémoire à changement de phase avec électrode de nanofil
169	US020070010094A1	11.01.2007	KREUPL FRANZ, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[EN] Method for depositing a conductive carbon material on a semiconductor for forming a Schottky contact and semiconductor contact device
168	US020060261419A1	23.11.2006	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[EN] Method for fabricating a nanoelement field effect transistor with surrounded gate structure

167	DE000010250829B4	02.11.2006	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Hofmann, Franz, Dr., 80995 München, DE Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kretz, Johannes, Dr., 80538 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Landgraf, Erhard, 81543 München, DE Luyken, R. Johannes, Dr., 81825 München, DE Rösner, Wolfgang, Dr., 85521 Ottobrunn, DE Schulz, Thomas, 81737 München, DE Specht, Michael, Dr., 80799 München, DE	[DE] Nichtflüchtige Speicherzelle, Speicherzellen-Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer nichtflüchtigen Speicherzelle
166	US000007129173B2	31.10.2006	DRUMMER HEIKE, DE ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SAENGER ANNETTE, DE SELL BERNHARD, US THIEME PETER, DE	[EN] Process for producing and removing a mask layer
165	EP000001714310A1	25.10.2006	KREUPL FRANZ, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHIEDUNG EINES LEITFÄHIGEN KOHLENSTOFFMATERIALS AUF EINEM HALBLEITER ZUR AUSBILDUNG EINES SCHOTTKY-KONTAKTES UND HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN] METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE ...
164	US020060234080A1	19.10.2006	GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[EN] Integrated electronic component
163	DE000010345394B4	05.10.2006	Gutsche, Martin, 84405 Dorfen, DE Kreupl, Franz, 80802 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen von Speicherzellen
162	EP000001706906A1	04.10.2006	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER MIT NANODRÄHTEN SOWIE DAFÜR GEEIGNETES HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] POWER SEMICONDUCTOR SWITCH HAVING NANOWIRES AND SUITABLE PRODUCTION METHOD THEREFOR [FR] COMMUTATEUR ...
161	KR102006103455A	29.09.2006	KRETZ JOHANNES, AT KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE STEINLESBERGER GERNOT, AT	[EN] BRIDGE FIELD-EFFECT TRANSISTOR STORAGE CELL, DEVICE COMPRISING SAID CELLS AND METHOD FOR PRODUCING A BRIDGE FIELD-EFFECT TRANSISTOR STORAGE CELL

160	EP000001704595A2	27.09.2006	KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] STEG-FELDEFFEKTTTRANSISTOR- SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] BRIDGE FIELD-EFFECT TRANSISTOR STORAGE CELL, DEVICE COMPRISING SAID CELLS AND METHOD FOR PRODUCING A BRIDGE FIELD-EFFECT ...
159	EP000001702371A1	20.09.2006	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES NANOELEMENT- FELDEFFEKTTTRANSISTORS MIT SURROUNDED GATE STRUKTUR [EN] METHOD FOR THE PRODUCTION A NANOELEMENT FIELD EFFECT TRANSISTOR, NANOELEMENT-FIELD EFFECT TRANSISTOR ...
158	US020060186451A1	24.08.2006	DUSBERG GEORG, US GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Memory device for storing electric charge, and method for fabricating it
157	US000007081383B2	25.07.2006	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Method for fabricating memory cells and memory cell array
156	US020060154467A1	13.07.2006	HOFFMAN FRANZ, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Method for the production of a memory cell, memory cell and memory cell arrangement
155	WO002006039907A 3	22.06.2006	DUESBERG GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR [EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR CONTACTING A NANOSTRUCTURE ...
154	US020060128088A1	15.06.2006	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE HONLEIN WOLFGANG, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN JOHANNES R, DE ROSNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[EN] Vertical integrated component, component arrangement and method for production of a vertical integrated component
153	WO002006039907A 2	20.04.2006	DUESBERG GEORG, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR [EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR CONTACTING A NANOSTRUCTURE ...

152	DE102004049452A1	20.04.2006	Dreeskornfeld, Lars, Dr., 85579 Neubiberg, DE Düsberg, Georg Stefan, Dr., 81541 München, DE Hartwich, Jessica, Dr., 85579 Neubiberg, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Steinlesberger, Gernot, Dr., 80804 München, DE	[DE] Mikroelektronisches Halbleiterbauelement und Verfahren zum Herstellen eines mikroelektronischen Halbleiterbauelements [EN] Microelectronic semiconductor component has at least one electrode comprising ...
151	DE102004049453A1	20.04.2006	Düsberg, Georg Stefan, Dr., 81541 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Seidel, Robert, 81539 München, DE Steinlesberger, Gernot, Dr., 80804 München, DE	[DE] Elektrischer Schaltkreis mit einer Nanostruktur und Verfahren zum Herstellen einer Kontaktierung einer Nanostruktur
150	CN000001754258A	29.03.2006	ANDREW SEIDEL ROBERT KREUPL FR, DE	[EN] Integrated electronic component having specifically produced nanotubes in vertical structures
149	US020060011972A1	19.01.2006	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE HONLEIN WOLFGANG, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDORAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD J, DE ROSNER WOLFGANG, DE SCHULTZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[EN] Non-volatile memory cell, memory cell arrangement and method for production of a non-volatile memory cell
148	DE102004031128A1	19.01.2006	Engelhardt, Manfred, Dr., 83620 Feldkirchen-Westerham, DE Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Steinlesberger, Gernot, Dr., 80804 München, DE	[DE] Elektrischer Schaltkreis mit einer Kohlenstoff-Leiterstruktur und Verfahren zum Herstellen einer Kohlenstoff-Leiterstruktur eines elektrischen Schaltkreises
147	CN000001720625A	11.01.2006	FRANZ HOFMANN FRANZ KREUPL, DE	[EN] Method for the production of a memory cell, memory cell and memory cell arrangement
146	WO002006000175A1	05.01.2006	ENGELHARDT MANFRED, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT EINER KOHLENSTOFF-LEITERSTRUKTUR UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER KOHLENSTOFF-LEITERSTRUKTUR EINES ELEKTRISCHEN SCHALTKREISES [EN] ELECTRIC CIRCUIT COMPRISING A CARBON ...

145	DE000019860084B4	22.12.2005	Engelhardt, Manfred, Dr., 83620 Feldkirchen-Westerham, DE Hartner, Walter, 81829 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Schiele, Manuela, 85625 Glonn, DE Sanger, Annette, Dr., 81667 Munchen, DE Weinrich, Volker, Dr., 81373 Munchen, DE	[DE] Verfahren zum Strukturieren eines Substrats
144	US020050276093A1	15.12.2005	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE HONLEIN WOLFGANG, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD J, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, US SPECHT MICHAEL, DE	[EN] Memory cell, memory cell arrangement, patterning arrangement, and method for fabricating a memory cell
143	DE102004023301A1	15.12.2005	KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzelle, Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzellen- Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzelle [EN] Bridge field effect transistor ...
142	EP000001597760A1	23.11.2005	GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] INTEGRIERTES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GEZIELT ERZEUGTEN NANOROHREN IN VERTIKALEN STRUKTUREN [EN] INTEGRATED ELECTRONIC COMPONENT HAVING SPECIFICALLY PRODUCED NANOTUBES IN VERTICAL STRUCTURES ...
141	WO002005060000A 3	27.10.2005	KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] STEG-FELDEFFEKTTTRANSISTOR- SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] BRIDGE FIELD-EFFECT TRANSISTOR STORAGE CELL, DEVICE COMPRISING SAID CELLS AND METHOD FOR PRODUCING A BRIDGE FIELD-EFFECT ...

140	US020050224888A1	13.10.2005	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE HONLEIN WOLFGANG, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD J, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, US SPECHT MICHAEL, DE	[EN] Integrated circuit array
139	DE102004012044A1	29.09.2005	Kreupl, Franz, 80802 München, DE Steinlesberger, Gernot, 80804 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen einer im Wesentlichen aus Kohlenstoff bestehenden Schicht, eine Sondeneinheit, ein Verfahren zum Herstellen einer Sondeneinheit und ein Rasterkraftmikroskop mit einer Sondeneinheit ...
138	US020050196950A1	08.09.2005	HONLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE STEINHOGL WERNER, DE	[EN] Method of producing layered assembly and a layered assembly
137	DE102004006544B3	08.09.2005	Kreupl, Franz, 80802 München, DE Steinlesberger, Gernot, 80804 München, DE	[DE] Verfahren zur Abscheidung eines leitfähigen Kohlenstoffmaterials auf einem Halbleiter zur Ausbildung eines Schottky-Kontaktes und Halbleiterkontaktvorrichtung
136	WO002005081296A1	01.09.2005	KREUPL FRANZ, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHIEDUNG EINES LEITFÄHIGEN KOHLENSTOFFMATERIALS AUF EINEM HALBLEITER ZUR AUSBILDUNG EINES SCHOTTKY-KONTAKTES UND HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN] METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE ...
135	EP000001568087A1	31.08.2005	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] NICHTFLÜCHTIGE SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND V ERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER NICHTFLÜCHTIGEN SPEICHERZELLE [EN] NON-VOLATILE MEMORY CELL, MEMORY CELL ARRANGEMENT AND METHOD FOR PRODUCTION ...
134	DE102004003374A1	25.08.2005	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Seidel, Robert, 81539 München, DE	[DE] Halbleiter-Leistungsschalter sowie dafür geeignetes Herstellungsverfahren
133	US000006930052B2	16.08.2005	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWARZL SIEGFRIED, DE	[EN] Method for producing an integrated circuit having at least one metalized surface

132	WO002005071754A1	04.08.2005	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER SOWIE DAFÜR GEEIGNETES HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] SEMI-CONDUCTOR CIRCUIT AND SUITABLE PRODUCTION METHOD THEREFOR [FR] DISJONCTEUR A SEMI-CONDUCTEUR, ET PROCEDE DE PRODUCTION ...
131	DE102004001340A1	04.08.2005	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Seidel, Robert, 81539 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen eines Nanelement-Feldeffekttransistors, Nanelement-Feldeffekttransistor und Nanelement-Anordnung
130	EP000001556893A2	27.07.2005	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG, STRUKTURIER-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE [EN] MEMORY CELL, MEMORY CELL ARRANGEMENT, STRUCTURING ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
129	EP000001556908A2	27.07.2005	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR-ANORDNUNG UND SCHALTKREIS-ARRAY [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR ASSEMBLY AND AN INTEGRATED CIRCUIT ARRAY [FR] ENSEMBLE TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP ET RESEAU DE CIRCUITS DE COMMUTATION
128	EP000001556909A1	27.07.2005	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, US SPECHT MICHAEL, DE	[DE] VERTIKAL INTEGRIERTES BAUELEMENT, BAUELEMENT-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES VERTIKAL INTEGRIERTEN BAUELEMENTS [EN] VERTICAL INTEGRATED COMPONENT, COMPONENT ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...

127	WO002005033358A 3	21.07.2005	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE PAMLER WERNER, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHIEDUNG EINES LEITFÄHIGEN MATERIALS AUF EINEM SUBSTRAT UND HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN] METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE MATERIAL ON A SUBSTRATE, AND SEMICONDUCTOR CONTACT ...
126	WO002005067075A 1	21.07.2005	KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES NANOELEMENT- FELDEFFEKTTTRANSISTORS, NANOELEMENT-FELDEFFEKTTTRANSISTOR MIT SURROUNDED GATE STRUKTUR [EN] METHOD FOR THE PRODUCTION A NANOELEMENT FIELD EFFECT TRANSISTOR, ...
125	DE000010344814B3	14.07.2005	DUESBERG GEORG, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] Speichervorrichtung zur Speicherung elektrischer Ladung und Verfahren zu deren Herstellung
124	DE000010359889A1	14.07.2005	KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzelle, Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzellen- Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzelle [EN] Bridge field effect transistor ...
123	US020050148174A1	07.07.2005	DUSBERG GEORG S, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[EN] Contact-connection of nanotubes
122	TW0000001235437B	01.07.2005	DUESBERG GEORG STEFAN, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[EN] Nanotube contact-making
121	WO002005060000A 2	30.06.2005	KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE STEINLESBERGER GERNOT, DE	[DE] STEG-FELDEFFEKTTTRANSISTOR- SPEICHERZELLE, STEG- FELDEFFEKTTTRANSISTOR- SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER STEG-FELDEFFEKTTTRANSISTOR- SPEICHERZELLE [EN] BRIDGE FIELD- EFFECT TRANSISTOR ...
120	DE000010345393A1	19.05.2005	Kreupl, Franz, 80802 München, DE Pamler, Werner, 80686 München, DE Seidel, Robert, 81539 München, DE	[DE] Verfahren zur Abscheidung eines leitfähigen Materials auf einem Substrat und Halbleiterkontaktvorrichtung

119	DE000010345394A1	19.05.2005	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen von Speicherzellen und Speicherzellenfeld
118	US020050095780A1	05.05.2005	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Method for fabricating memory cells and memory cell array
117	WO002005038814A1	28.04.2005	DUESBERG GEORG STEFAN, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] SPEICHERVORRICHTUNG ZUR SPEICHERUNG ELEKTRISCHER LADUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG [EN] STORAGE DEVICE FOR STORING ELECTRIC CHARGE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME [FR] DISPOSITIF DE STOCKAGE ...
116	WO002005033358A2	14.04.2005	GUTSCHE MARTIN, DE KREUPL FRANZ, DE PAMLER WERNER, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHIEDUNG EINES LEITFÄHIGEN MATERIALS AUF EINEM SUBSTRAT UND HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN] METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE MATERIAL ON A SUBSTRATE, AND SEMICONDUCTOR CONTACT ...
115	DE000010335813A1	17.03.2005	KREUPL FRANZ, DE MIO HANNES, DE	[DE] IC-Chip mit Nanowires
114	CN000001192427C	09.03.2005	ENGELHARDT M, DE KREUPL F, DE SCHWARZL S, DE	[EN] Method for producing integrated circuit having at least one metallized surface
113	US020050029654A1	10.02.2005	KREUPL FRANZ, DE MIO HANNES, DE	[EN] IC chip with nanowires
112	EP000001505646A1	09.02.2005	KREUPL FRANZ, DE MIO HANNES, DE	[DE] IC-Chip mit Nanowire-Bauelemente und Nanowire-Attrappen [EN] IC-Chip with nanowire devices and dummy nanowire devices [FR] Puce IC avec des dispositifs nanofils et des dispositifs fictifs nanofils
111	DE000010331528A1	03.02.2005	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Tews, Helmut, Dr., 81549 München, DE	[DE] DRAM-Halbleiterspeicherzelle sowie Verfahren zu deren Herstellung
110	EP000001502299A2	02.02.2005	DUESBERG GEORG STEFAN, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[DE] KONTAKTIERUNG VON NANORÖHREN [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR] ETABLISSEMENT DES CONTACTS DE NANOTUBES
109	WO002005008770A1	27.01.2005	KREUPL FRANZ, DE TEWS HELMUT, DE	[DE] DRAM-HALBLEITERSPEICHERZELLE SOWIE VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG [EN] DRAM-SEMI CONDUCTOR MEMORY CELL AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF [FR] CELLULE MEMOIRE A SEMI-CONDUCTEUR DE TYPE MEMOIRE ...

108	DE000010325334A1	05.01.2005	Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen eines Substrats mit sublithographischen Bereichen [EN] Forming sublithographic regions on or in substrate, involves forming first sublithographic structure by anodic oxidation ...
107	US020040232426A1	25.11.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD, DE ROSNER WOLFGANG, DE	[EN] Nanotube array and method for producing a nanotube array
106	US020040233649A1	25.11.2004	HONLEIN WOLFGANG, DE KLOSE HELMUT, DE KLOSE HYANG-SOOK, DE KREUPL FRANZ, DE SIMBURGER WERNER, DE	[EN] Electronic chip and electronic chip assembly
105	DE000010307815B3	11.11.2004	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE Seidel, Robert, 81539 München, DE	[DE] Integriertes elektronisches Bauelement mit gezielt erzeugten Nanoröhren in vertikalen Strukturen und dessen Herstellungsverfahren
104	US000006809361B2	26.10.2004	HONLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Magnetic memory unit and magnetic memory array
103	US000006809379B2	26.10.2004	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Field effect transistor and method for producing a field effect transistor
102	WO002004051763A3	30.09.2004	HOFMANN FRANZ, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLE UND SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG [EN] METHOD FOR THE PRODUCTION OF A MEMORY CELL, MEMORY CELL AND MEMORY CELL ARRANGEMENT [FR] PROCEDE DE ...
101	US000006798000B2	28.09.2004	HANEDER THOMAS PETER, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE SCHLOESSER TILL, DE	[EN] Field effect transistor
100	US020040183110A1	23.09.2004	HONLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND MAGNETIC MEMORY ARRAY
99	EP000001454355A2	08.09.2004	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE STEINHOEGL WERNER, DE	[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SCHICHT-ANORDNUNG UND SCHICHT-ANORDNUNG [EN] METHOD FOR PRODUCING A LAYERED ASSEMBLY AND A LAYERED ASSEMBLY [FR] PROCEDE DE PRODUCTION D'UN SYSTEME STRATIFIE ET SYSTEME ...

98	WO002004075288A 1	02.09.2004	GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE SEIDEL ROBERT, DE	[DE] INTEGRIERTES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GEZIELT ERZEUGTEN NANORÖHREN IN VERTIKALEN STRUKTUREN [EN] INTEGRATED ELECTRONIC COMPONENT HAVING SPECIFICALLY PRODUCED NANOTUBES IN VERTICAL STRUCTURES ...
97	US000006777731B2	17.08.2004	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Magnetoresistive memory cell with polarity-dependent resistance
96	WO002004040644A 3	12.08.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN- ANORDNUNG, STRUKTURIER- ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE [EN] MEMORY CELL, MEMORY CELL ARRANGEMENT, STRUCTURING ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
95	WO002003061004A 3	29.07.2004	BREDERLOW RALF, DE ELBE ASTRID, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN JOHANNES, DE NEUHAUSER ROBERT, DE PAULUS CHRISTIAN, DE SCHEPERS JOERG, DE THEWES ROLAND, DE	[DE] VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND AUTHENTIFIZIERUNG VON HALBLEITERSCHALTUNGEN [EN] METHOD FOR CODING AND AUTHENTICATING SEMICONDUCTOR CIRCUITS [FR] PROCEDE POUR CODER ET AUTHENTIFIER DES CIRCUITS DE SEMI- CONDUCTEURS
94	WO002003094226A 3	22.07.2004	DUESBERG GEORG STEFAN, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[DE] KONTAKTIERUNG VON NANORÖHREN [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR] ETABLISSEMENT DES CONTACTS DE NANOTUBES
93	DE000010256486A1	15.07.2004	Hofmann, Franz, Dr., 80995 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen einer Speicherzelle, Speicherzelle und Speicherzellen-Anordnung
92	WO002004040668A 3	08.07.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR- ANORDNUNG UND SCHALTKREIS-ARRAY [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR ASSEMBLY AND AN INTEGRATED CIRCUIT ARRAY [FR] ENSEMBLE TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP ET RESEAU DE CIRCUITS DE COMMUTATION
91	CN000001155063C	23.06.2004	KREUPL F, DE WEINRICH M ENGELHARDT V, DE	[EN] Method for producing semiconductor memory component

90	AU002003289813A1	23.06.2004	HOFMANN FRANZ KREUPL FRANZ	[EN] METHOD FOR THE PRODUCTION OF A MEMORY CELL, MEMORY CELL AND MEMORY CELL ARRANGEMENT
89	WO002004051763A2	17.06.2004	HOFMANN FRANZ, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLE UND SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG [EN] METHOD FOR THE PRODUCTION OF A MEMORY CELL, MEMORY CELL AND MEMORY CELL ARRANGEMENT [FR] PROCEDE DE ...
88	DE000010250834A1	19.05.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE KREUPL FRANZ, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] Speicherzelle, Speicherzellen-Anordnung, Strukturier-Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer Speicherzelle
87	DE000010250868A1	19.05.2004	Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE	[DE] Vertikal integriertes Bauelement, Bauelement-Anordnung und Verfahren zum Herstellen eines vertikal integrierten Bauelements
86	WO002004040644A2	13.05.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG, STRUKTURIER-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE [EN] MEMORY CELL, MEMORY CELL ARRANGEMENT, STRUCTURING ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
85	WO002004040666A1	13.05.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] VERTIKAL INTEGRIERTES BAUELEMENT, BAUELEMENT-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES VERTIKAL INTEGRIERTEN BAUELEMENTS [EN] VERTICAL INTEGRATED COMPONENT, COMPONENT ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
84	WO002004040667A1	13.05.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] NICHTFLÜCHTIGE SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER NICHTFLÜCHTIGEN SPEICHERZELLE [EN] NON-VOLATILE MEMORY CELL, MEMORY CELL ARRANGEMENT AND METHOD FOR PRODUCTION ...

83	WO002004040668A2	13.05.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LANDGRAF ERHARD, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE SCHULZ THOMAS, DE SPECHT MICHAEL, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR- ANORDNUNG UND SCHALTKREIS-ARRAY [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR ASSEMBLY AND AN INTEGRATED CIRCUIT ARRAY [FR] ENSEMBLE TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP ET RESEAU DE CIRCUITS DE COMMUTATION
82	US020040092093A1	13.05.2004	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWARZL SIEGFRIED, DE	[EN] Method for producing an integrated circuit having at least one metalized surface
81	KR102004038977A	08.05.2004	HOENLEIN WOLFGANG KREUPL FRANZ	[EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND MAGNETIC MEMORY ARRAY
80	EP000001412948A2	28.04.2004	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] MAGNETISCHE SPEICHEREINHEIT UND MAGNETISCHES SPEICHERARRAY [EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND MAGNETIC MEMORY ARRAY [FR] UNITE MEMOIRE MAGNETIQUE ET MATRICE MEMOIRE MAGNETIQUE
79	KR102004030653A	09.04.2004	HOENLEIN WOLFGANG KLOSE HELMUT KREUPL FRANZ SIMBUERGER WERNER	[EN] ELECTRONIC CHIP AND ELECTRONIC CHIP ASSEMBLY
78	US000006707098B2	16.03.2004	HOFMANN FRANZ, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE SCHLOESSER TILL, DE	[EN] Electronic device and method for fabricating an electronic device
77	US020040048479A1	11.03.2004	DRUMMER HEIKE, DE ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SANGER ANNETTE, FR SELL BERNHARD, US THIEME PETER, DE	[EN] Process for producing and removing a mask layer
76	EP000001393370A2	03.03.2004	HOENLEIN WOLFGANG, DE KLOSE HELMUT, DE KREUPL FRANZ, DE SIMBUERGER WERNER, DE	[DE] ELEKTRONISCHER CHIP UND ELEKTRONISCHE CHIP-ANORDNUNG [EN] ELECTRONIC CHIP AND ELECTRONIC CHIP ASSEMBLY [FR] PUCE ELECTRONIQUE ET SYSTEME DE PUCES ELECTRONIQUES
75	EP000001390295A2	25.02.2004	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE	[DE] NANORÖHREN-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER NANORÖHREN-ANORDNUNG [EN] NANOTUBE ARRAY AND METHOD FOR PRODUCING A NANOTUBE ARRAY [FR] ENSEMBLE A NANOTUBES ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN ...

74	DE000010220194A1	27.11.2003	Düsberg, Georg S., Dr.rer.nat., 80469 München, DE Graham, Andrew Ph. D., Dr., 81547 München, DE Kreupl, Franz, Dr.rer.nat., 80802 München, DE Liebau, Maik, Dr.rer.nat., 81735 München, DE Unger, Eugen, Dr.rer.nat., 86161 Augsburg, DE	[DE] Kontaktierung von Nanoröhren
73	EP000001364391A1	26.11.2003	DRUMMER HEIKE, DE ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SAENGER ANNETTE, DE SELL BERNHARD, US THIEME PETER, DE	[DE] VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG EINER MASKENSCHICHT VON EINEM HALBLEITERSUBSTRAT [EN] METHOD FOR REMOVING A MASK LAYER FROM A SEMICONDUCTOR SUBSTRATE [FR] PROCEDE POUR ENLEVER UNE COUCHE DE MASQUAGE D'UN ...
72	TW000000563253B	21.11.2003	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Field effect transistor and method for producing a field effect transistor
71	TW000001563253B	21.11.2003	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Field effect transistor and method for producing a field effect transistor
70	WO002003094226A2	13.11.2003	DUESBERG GEORG STEFAN, DE GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU MAIK, DE UNGER EUGEN, DE	[DE] KONTAKTIERUNG VON NANORÖHREN [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR] ETABLISSEMENT DES CONTACTS DE NANOTUBES
69	KR102003076694A	26.09.2003	DRUMMER HEIKE KREUPL FRANZ SAENGER ANNETTE ENGELHARDT MANFRED SELL BERNHARD THIEME PETER	[EN] METHOD FOR REMOVING A MASK LAYER FROM A SEMICONDUCTOR SUBSTRATE
68	US020030179559A1	25.09.2003	ENGELHARDT MANFRED, DE HONLEI WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Electronic component comprising an electrically conductive connection consisting of carbon nanotubes and a method for producing the same
67	WO002003050868A3	04.09.2003	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE STEINHOEGL WERNER, DE	[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SCHICHT-ANORDNUNG UND SCHICHT-ANORDNUNG [EN] METHOD FOR PRODUCING A LAYERED ASSEMBLY AND A LAYERED ASSEMBLY [FR] PROCEDE DE PRODUCTION D'UN SYSTEME STRATIFIE ET SYSTEME ...
66	WO002002099845A3	21.08.2003	HOENLEIN WOLFGANG, DE KLOSE HELMUT, DE KREUPL FRANZ, DE SIMBUERGER WERNER, DE	[DE] ELEKTRONISCHER CHIP UND ELEKTRONISCHE CHIP-ANORDNUNG [EN] ELECTRONIC CHIP AND ELECTRONIC CHIP ASSEMBLY [FR] PUCE ELECTRONIQUE ET SYSTEME DE PUCES ELECTRONIQUES

65	US020030155591A1	21.08.2003	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Field effect transistor and method for producing a field effect transistor
64	DE000010202903A1	14.08.2003	KREUPL FRANZ, DE	[DE] Magnetoresistive Speicherzelle mit polaritätsabhängigem Widerstand
63	US020030148562A1	07.08.2003	HANEDER THOMAS PETER, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE SCHLOESSER TILL, DE	[EN] Field effect transistor
62	DE000010201645A1	07.08.2003	BREDERLOW RALF, DE ELBE ASTRID, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN JOHANNES, DE NEUHAUSER ROBERT, DE PAULUS CHRISTIAN, DE SCHEPERS JOERG, DE THEWES ROLAND, DE	[DE] Verfahren zur Codierung und Authentifizierung von Halbleiterschaltungen
61	US020030142562A1	31.07.2003	KREUPL FRANZ, DE	[EN] Magnetoresistive memory cell with polarity-dependent resistance
60	WO002003061004A2	24.07.2003	BREDERLOW RALF, DE ELBE ASTRID, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN JOHANNES, DE NEUHAUSER ROBERT, DE PAULUS CHRISTIAN, DE SCHEPERS JOERG, DE THEWES ROLAND, DE	[DE] VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND AUTHENTIFIZIERUNG VON HALBLEITERSCHALTUNGEN [EN] METHOD FOR CODING AND AUTHENTICATING SEMICONDUCTOR CIRCUITS [FR] PROCEDE POUR CODER ET AUTHENTIFIER DES CIRCUITS DE SEMI-CONDUCTEURS
59	DE000010161312A1	10.07.2003	Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Steinhögl, Werner, Dr., 80802 München, DE	[DE] Verfahren zum Herstellen einer Schicht-Anordnung und Schicht-Anordnung
58	WO002003050868A2	19.06.2003	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE STEINHOEGL WERNER, DE	[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SCHICHT-ANORDNUNG UND SCHICHT-ANORDNUNG [EN] METHOD FOR PRODUCING A LAYERED ASSEMBLY AND A LAYERED ASSEMBLY [FR] PROCEDE DE PRODUCTION D'UN SYSTEME STRATIFIE ET SYSTEME ...
57	US000006566220B2	20.05.2003	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHIELE MANUELA, GB WEINRICH VOLKER, FR	[EN] Method for fabricating a semiconductor memory component

56	WO002003007304A 3	01.05.2003	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] MAGNETISCHE SPEICHEREINHEIT UND MAGNETISCHES SPEICHERARRAY [EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND MAGNETIC MEMORY ARRAY [FR] UNITE MEMOIRE MAGNETIQUE ET MATRICE MEMOIRE MAGNETIQUE
55	EP000001299914A1	09.04.2003	HANEDER THOMAS PETER, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE SCHLOESSER TILL, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR [FR] TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP
54	TW000000526542B	01.04.2003	DRUMMER HEIKE, DE ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SAENGER ANNETTE, DE SELL BERNHARD, DE	[EN] Method for removing a mask layer from a semiconductor substrate
53	TW000000526542B	01.04.2003	SELL BERNHARD, DE KREUPL FRANZ, DE DRUMMER HEIKE, DE SAENGER ANNETTE, DE ENGELHARDT MANFRED, DE	[EN] Method for removing a mask layer from a semiconductor substrate
52	EP000001287563A1	05.03.2003	KREUPL FRANZ, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES FELDEFFEKTTRANSISTORS [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR AND METHOD FOR PRODUCING A FIELD EFFECT TRANSISTOR [FR] TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP ET ...
51	WO002002092505A 3	27.02.2003	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE	[DE] NANORÖHREN-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER NANORÖHREN-ANORDNUNG [EN] NANOTUBE ARRAY AND METHOD FOR PRODUCING A NANOTUBE ARRAY [FR] ENSEMBLE A NANOTUBES ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN ...
50	DE000010204875C 1	27.02.2003	BREDERLOW RALF, DE ELBE ASTRID, DE HOFMANN FRANZ, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN JOHANNES, DE NEUHAUSER ROBERT, DE PAULUS CHRISTIAN, DE SCHEPERS JOERG, DE SIPRAK DOMAGOJ, DE THEWES ROLAND, DE WEBER WERNER, DE	[DE] IC-Chip mit Manipulationsschutz und Verfahren [EN] IC chip with manipulation protection for use in chip card, is provided by layer structure with given electrical characteristics checked to verify ...

49	DE000010113549C 2	06.02.2003	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Unger, Eugen, Dr., 86161 Augsburg, DE	[DE] Verfahren zum Wachsen von Nanoröhren
48	DE000010132787A1	30.01.2003	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE	[DE] Katalysatormaterial, Kohlenstoffnanoröhren-Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer Kohlenstoffnanoröhren-Anordnung
47	DE000010133373A1	30.01.2003	Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE	[DE] Magnetische Speichereinheit und magnetisches Speicherarray
46	WO002003007304A 2	23.01.2003	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] MAGNETISCHE SPEICHEREINHEIT UND MAGNETISCHES SPEICHERARRAY [EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND MAGNETIC MEMORY ARRAY [FR] UNITE MEMOIRE MAGNETIQUE ET MATRICE MEMOIRE MAGNETIQUE
45	WO002003004155A 1	16.01.2003	GRAHAM ANDREW, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] KOHLENSTOFFNANORÖHREN-KATALYSATORMATERIAL, KOHLENSTOFFNANORÖHREN-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER KOHLENSTOFFNANORÖHREN-ANORDNUNG [EN] CARBON NANOTUBE CATALYST MATERIAL, CARBON NANOTUBE ...
44	DE000010127351A1	19.12.2002	Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Klose, Helmut, Dr., 81479 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Simbürger, Werner, Dr., 85540 Haar, DE	[DE] Elektronischer Chip und elektronische Chip-Anordnung [EN] Electronic chip comprises several external contacts of which at least two are provided with a plurality of nanotubes for purposes of contacting ...
43	WO002002099845A 2	12.12.2002	HOENLEIN WOLFGANG, DE KLOSE HELMUT, DE KREUPL FRANZ, DE SIMBUERGER WERNER, DE	[DE] ELEKTRONISCHER CHIP UND ELEKTRONISCHE CHIP-ANORDNUNG [EN] ELECTRONIC CHIP AND ELECTRONIC CHIP ASSEMBLY [FR] PUCE ELECTRONIQUE ET SYSTEME DE PUCES ELECTRONIQUES
42	KR102002092434A	11.12.2002	KREUPL FRANZ	[EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR AND METHOD FOR PRODUCING A FIELD EFFECT TRANSISTOR
41	EP000001264344A1	11.12.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT EINER ELEKTRISCH LEITENDEN VERBINDUNG AUS CARBON-NANORÖHREN UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG [EN] ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING AN ELECTRICALLY CONDUCTIVE CONNECTION ...

40	DE000010034315C2	28.11.2002	Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Paulus, Christian, 81247 München, DE Sauerbrey, Jens, 82024 Taufkirchen, DE Thewes, Roland, Dr., 82194 Gröbenzell, DE	[DE] Analog-Digital-Wandler
39	DE000010123876A1	28.11.2002	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Hofmann, Franz, Dr., 80995 München, DE Kretz, Johannes, Dr., 80538 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Luyken, Johannes R., Dr., 81825 München, DE Rösner, Wolfgang, Dr., 85521 Ottobrunn, DE	[DE] Nanoröhren-Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer Nanoröhren-Anordnung [EN] Nanotube array comprises a substrate, a catalyst layer having partial regions on the surface of the substrate, nanotubes ...
38	WO002002092505A2	21.11.2002	GRAHAM ANDREW, DE HOFMANN FRANZ, DE KRETZ JOHANNES, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE ROESNER WOLFGANG, DE	[DE] NANORÖHREN-ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER NANORÖHREN-ANORDNUNG [EN] NANOTUBE ARRAY AND METHOD FOR PRODUCING A NANOTUBE ARRAY [FR] ENSEMBLE A NANOTUBES ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN ...
37	CN000001377511A	30.10.2002	ENGELHARDT M, DE KREUPL F, DE SCHWARZL S, DE	[EN] Method for producing integrated circuit having at least one metallized surface
36	US020020153160A1	24.10.2002	HOFMANN FRANZ, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE SCHLOESSER TILL, DE	[EN] Electronic device and method for fabricating an electronic device
35	KR102002079854A	19.10.2002	ENGELHARDT MANFRED HOENLEIN WOLFGANG KREUPL FRANZ	[EN] ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING AN ELECTRICALLY CONDUCTIVE CONNECTION CONSISTING OF CARBON NANOTUBES AND A METHOD FOR PRODUCING THE SAME
34	DE000010113549A1	02.10.2002	Graham, Andrew, Dr., 81547 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Unger, Eugen, Dr., 86161 Augsburg, DE	[DE] Verfahren zum Wachsen von Nanoröhren, Substrat und Halbleiterelement [EN] Process for growing nanotubes used in the production of a semiconductor element comprises contacting a substrate with a ...
33	TW000000503482B	21.09.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Semiconductor electronic device, method for producing a conductive connection in a semiconductor electronic device, and method for producing a semiconductor electronic device

32	TW000001503482B	21.09.2002	HOENLEIN WOLFGANG, DE ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Semiconductor electronic device, method for producing a conductive connection in a semiconductor electronic device, and method for producing a semiconductor electronic device
31	WO002002069378A 1	06.09.2002	DRUMMER HEIKE, DE ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SAENGER ANNETTE, DE SELL BERNHARD, DE THIEME PETER, DE	[DE] VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG EINER MASKENSCHICHT VON EINEM HALBLEITERSUBSTRAT [EN] METHOD FOR REMOVING A MASK LAYER FROM A SEMICONDUCTOR SUBSTRATE [FR] PROCEDE POUR ENLEVER UNE COUCHE DE MASQUAGE D'UN ...
30	US020020115253A1	22.08.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHIELE MANUELA, GB WEINRICH VOLKER, FR	[EN] Method for fabricating a semiconductor memory component
29	DE000010103340A1	22.08.2002	Hönlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE	[DE] Verfahren zum Wachsen von Kohlenstoff-Nanoröhren oberhalb einer elektrisch zu kontaktierenden Unterlage sowie Bauelement
28	WO002002059392A 1	01.08.2002	HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] VERFAHREN ZUM WACHSEN VON KOHLENSTOFF-NANORÖHREN OBERHALB EINER ELEKTRISCH ZU KONTAKTIERENDEN UNTERLAGE SOWIE BAUELEMENT [EN] METHOD FOR GROWING CARBON NANOTUBES ABOVE A BASE THAT IS TO BE ELECTRICALLY ...
27	US020020098679A1	25.07.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWARZL SIEGFRIED, DE	[EN] Method for producing an integrated circuit having at least one metalized surface
26	CN000001354887A	19.06.2002	ENGELHARDT M, DE KREUPL F, DE WEINRICH V, DE	[EN] Method for producing semiconductor memory component
25	EP000001212794A2	12.06.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWARZL SIEGFRIED, DE	[DE] VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG MIT MINDESTENS EINER METALLISIERUNGSEBENE [EN] METHOD FOR PRODUCING AN INTEGRATED CIRCUIT HAVING AT LEAST ONE METALLISED SURFACE [FR] PROCEDE ...
24	DE000010056282A1	23.05.2002	Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Weber, Werner, Dr., 80637 München, DE	[DE] Künstliches Neuron, elektronische Schaltungsanordnung und künstliches neuronales Netz [EN] Artificial neuron comprises a transistor and a number of electrical contacts which can be contacted by ...

23	EP000001198828A1	24.04.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHIELE MANUELA, GB WEINRICH VOLKER, FR	[DE] VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERSPEICHERBAUELEMENTS [EN] METHOD FOR PRODUCING A SEMICONDUCTOR MEMORY COMPONENT [FR] PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COMPOSANT DE STOCKAGE A SEMI- CONDUCTEUR
22	KR102002025237A	03.04.2002	SCHWARZL SIEGFRIED ENGELHARDT MANFRED KREUPL FRANZ	[EN] METHOD FOR PRODUCING AN INTEGRATED CIRCUIT HAVING AT LEAST ONE METALICIZED SURFACE
21	KR102002020908A	16.03.2002	ENGELHARDT MANFRED WEINRICH VOLKER KREUPL FRANZ SCHIELE MANUELA	[EN] METHOD FOR PRODUCING A SEMICONDUCTOR MEMORY COMPONENT
20	TW000000477039B	21.02.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHIELE MANUELA, DE WEINRICH VOLKER, DE	[EN] Method to manufacture semiconductor memory components
19	TW000001477039B	21.02.2002	ENGELHARDT MANFRED, DE WEINRICH VOLKER, DE KREUPL FRANZ, DE SCHIELE MANUELA, DE	[EN] Method to manufacture semiconductor memory components
18	DE000010006964C 2	31.01.2002	Engelhardt, Manfred, Dr.rer.nat., 83620 Feldkirchen- Westerham, DE Hönlein, Wolfgang, Dr.rer.nat., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr.rer.nat., 80469 München, DE	[DE] Elektronisches Bauelement mit einer leitenden Verbindung zwischen zwei leitenden Schichten und Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauelements
17	DE000010034315A1	31.01.2002	Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Paulus, Christian, 81247 München, DE Sauerbrey, Jens, 82024 Taufkirchen, DE Thewes, Roland, Dr., 82194 Gröbenzell, DE	[DE] Analog-Digital-Wandler [EN] Analog-digital converter has second electrode as flexible element extending freely in one direction and detector of variable distance between first and second electrodes
16	DE000010032412A1	24.01.2002	Engelhardt, Manfred, Dr., 83620 Feldkirchen-Westerham, DE Haneder, Thomas Peter, 81549 München, DE Hoenlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE	[DE] Elektronisches Speicherelement und Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Speicherelements [EN] Electronic storage element used in CMOS technology comprises carbon nanotubes arranged skew ...

15	WO002002003482A 1	10.01.2002	HANEDER THOMAS PETER, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES, DE SCHLOESSER TILL, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR [FR] TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP
14	EP000001170799A2	09.01.2002	HOFMANN FRANZ DR, DE KREUPL FRANZ DR, DE LUYKEN RICHARD JOHANNES DR, DE SCHLOESSER TILL DR, DE	[DE] Elektronisches Bauelement und Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauelements [EN] Electronic device and method of manufacture of an electronic device [FR] Dispositif électronique et procédé ...
13	DE000010032370C 1	13.12.2001	Haneder, Thomas Peter, 81549 München, DE Hoenlein, Wolfgang, Dr., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE	[DE] Feldeffekttransistor [EN] Carbon nanotube field effect transistor has two nanotubes spaced apart to prevent tunnel current between them
12	WO002001088996A 1	22.11.2001	KREUPL FRANZ, DE	[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES FELDEFFEKTTRANSISTORS [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR AND METHOD FOR PRODUCING A FIELD EFFECT TRANSISTOR [FR] TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP ET ...
11	TW000000461037B	21.10.2001	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWARZL SIEGFRIED, DE	[EN] Method for fabricating an integrated circuit having at least one metallization plane
10	TW000001461037B	21.10.2001	SCHWARZL SIEGFRIED, DE ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE	[EN] Method for fabricating an integrated circuit having at least one metallization plane
9	DE000010023871C 1	27.09.2001	KREUPL FRANZ, DE	[DE] Feldeffekttransistor und Verfahren zum Herstellen eines Feldeffekttransistors [EN] Field effect transistor comprises an electrically non-conducting substrate, a channel region between source and ...
8	DE000010006964A1	13.09.2001	Engelhardt, Manfred, Dr.rer.nat., 83620 Feldkirchen- Westerham, DE Hönlein, Wolfgang, Dr.rer.nat., 82008 Unterhaching, DE Kreupl, Franz, Dr.rer.nat., 80469 München, DE	[DE] Elektronisches Bauelement, Verfahren zum Herstellen einer leitenden Verbindung in einem elektronischen Bauelement und Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauelements

7	WO002001061753A 1	23.08.2001	ENGELHARDT MANFRED, DE HOENLEIN WOLFGANG, DE KREUPL FRANZ, DE	[DE] ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT EINER ELEKTRISCH LEITENDEN VERBINDUNG AUS CARBON-NANORÖHREN UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG [EN] ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING AN ELECTRICALLY CONDUCTIVE CONNECTION ...
6	WO002001015219A 3	19.07.2001	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWARZL SIEGFRIED, DE	[DE] VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG MIT MINDESTENS EINER METALLISIERUNGSEBENE [EN] METHOD FOR PRODUCING AN INTEGRATED CIRCUIT HAVING AT LEAST ONE METALICIZED SURFACE [FR] PROCEDE ...
5	WO002001015219A 2	01.03.2001	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHWARZL SIEGFRIED, DE	[DE] VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG MIT MINDESTENS EINER METALLISIERUNGSEBENE [EN] METHOD FOR PRODUCING AN INTEGRATED CIRCUIT HAVING AT LEAST ONE METALICIZED SURFACE [FR] PROCEDE ...
4	WO002000077841A 1	21.12.2000	ENGELHARDT MANFRED, DE KREUPL FRANZ, DE SCHIELE MANUELA, DE WEINRICH VOLKER, DE	[DE] VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERSPEICHERBAUELEMENTS [EN] METHOD FOR PRODUCING A SEMICONDUCTOR MEMORY COMPONENT [FR] PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COMPOSANT DE STOCKAGE A SEMI-CONDUCTEUR
3	DE000019926501A1	21.12.2000	Engelhardt, Manfred, Dr., 83620 Feldkirchen-Westerham, DE Kreupl, Franz, 80469 München, DE Schiele, Manuela, 85625 Glonn, DE Weinrich, Volker, Dr., 81373 München, DE	[DE] Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterspeicherbauelements
2	WO002000039847A 1	06.07.2000	ENGELHARDT MANFRED, DE HARTNER WALTER, DE KREUPL FRANZ, DE SAENGER ANNETTE, DE SCHIELE MANUELA, DE WEINRICH VOLKER, DE	[DE] VERFAHREN ZUM STRUKTURIEREN EINES SUBSTRATS SOWIE VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG EINES DERARTIGEN VERFAHRENS [EN] METHOD FOR STRUCTURING A SUBSTRATE AND DEVICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD [FR] PROCEDE ...

1	DE000019860084A1	06.07.2000	Engelhardt, Manfred, Dr., 83620 Feldkirchen-Westerham, DE Hartner, Walter, 81829 München, DE Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE Schiele, Manuela, 85625 Glonn, DE Sanger, Annette, Dr., 81667 Munchen, DE Weinrich, Volker, Dr., 81373 Munchen, DE	[DE] Verfahren zum Strukturieren eines Sub
---	------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------